

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

объявляет конкурс на замещение вакантной должности

младшего научного сотрудника

в лаборатории фотоэлектрических явлений в полупроводниках

Вакансия VAC_PTI_22048

Тематика исследований

Исследование электронных и оптических свойств халькогенидных стеклообразных полупроводников.

Трудовая деятельность

Моделирование электронных, оптических и иных свойств халькогенидных стеклообразных полупроводников, включая стеклообразные материалы на основе германия, сурьмы и теллура, используемые для разработки элементов фазовой памяти.

В трудовую деятельность входит:

- разработка и применение теоретических методов исследований эффектов памяти и переключения, включая эффекты шнурования тока, в халькогенидных стеклообразных полупроводниках;
- исследование квантоворазмерных эффектов в наноразмерных объектах на основе халькогенидных стеклообразных полупроводников при протекании электрического тока;
- исследование свойств неравновесного фононного газа, образующегося при шнуровании тока в халькогенидных стеклообразных полупроводниках;
- исследование свойств латеральных токов, формирующихся при шнуровании тока в халькогенидных стеклообразных полупроводниках
- анализ литературы и сравнение расчетных результатов расчетов с экспериментальными данными;
- подготовка научных статей на русском и английском языках.

Требования к кандидату:

- Владение программами моделирования (MatLab, Comsol);
- Знание статистической физики, методов расчета функции распределения;
- Опыт работы с программными пакетами для выполнения квантово-химических расчетов (Gaussian, Orca);
- Владение программами для обработки данных (OriginPro);
- Стаж научной работы по специальности не менее 3 лет.

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 23 800

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 18 000

СТАВКА: 0,5

Срок трудового договора – 5 лет

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы:

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург,

Политехническая ул., д. 26, ученому секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову,

телефон для справок: (812) 297 22 45.